



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

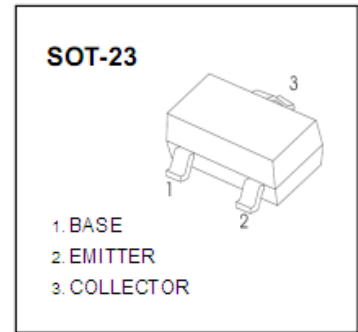
## 2SA1362 ( PNP )

### 特点/Features :

饱和压降小 ;

### 用途/Applications :

用于低频功率放大电路或开关电路。



### 极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	$V_{CB0}$	-10	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	$V_{CE0}$	-15	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	$V_{EB0}$	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	$I_C$	-0.8	A
基极连续电流/Base Current Continuous	$I_C$	-0.16	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	$P_C$	0.2	W
结温/Junction Temperature	$T_j$	150	°C
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	°C

### 电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	$I_C=-10mA, I_B=0$	-15			V
集电极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-15V, I_E=0$			-0.1	$\mu A$
发射极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-5V, I_C=0$			-0.1	$\mu A$
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1V, I_C=-100mA$	120		400	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1V, I_C=-800mA$	40			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-400mA, I_B=-8mA$			-0.2	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE}$	$V_{CE}=-1V, I_C=-10mA$	0.5		-0.8	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=-5V, I_C=-10mA$		120		MHz
集电极输出电容	$C_{ob}$	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$		13		pF

### 印章/Marking & $h_{FE}$ 分档/Classification of $h_{FE(1)}$

范围/Range	120~240	200~400
印章/Marking	AEY	AEG



### 典型特性曲线图/Typical Characteristics

